

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

29. 6. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 8 6 3 7 0
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 8 6 3 7 0]

出 願 人
Applicant(s): 田 辺 製 薬 株 式 会 社

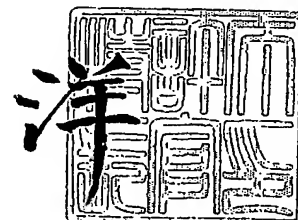
RECEIVED	
12 AUG 2004	
WIPO	PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 7 月 2 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 A00-4891

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C07D307/78

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市開田 4 - 3 4 - 1 3

【氏名】 関 雅彦

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県尼崎市武庫之荘 5 - 5 - 8

【氏名】 吉田 真一

【発明者】

【住所又は居所】 奈良県北葛城郡王寺町太子 1 - 1 6 - 4

【氏名】 矢木 信博

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市中庄 2 - 1 0 - 3 4

【氏名】 初田 正典

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府吹田市豊津町 1 8 - 1 1 - 2 0 3

【氏名】 木村 真弓

【特許出願人】

【識別番号】 000002956

【氏名又は名称】 田辺製薬株式会社

【代理人】

【識別番号】 100115473

【弁理士】

【氏名又は名称】 石津 義則

【電話番号】 06-6300-2722

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 016322

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0203318

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

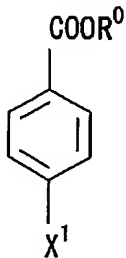
【発明の名称】 3-アシルアミノベンゾフラン-2-カルボン酸誘導体の製法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

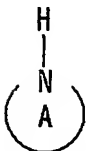
(A)

1) - a) 一般式 [I I] :



(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、 X^1 は脱離基を表す。)

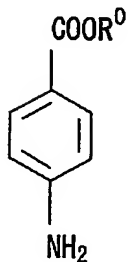
で示される化合物と一般式 [I I I] :



(式中、環Aは含窒素複素環式基を表す。)

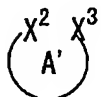
で示される化合物とを反応させるか、

1) - b) 一般式 [I V] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

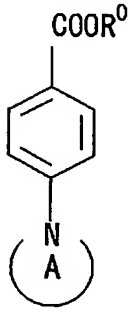
で示される化合物と一般式 [V] :



(式中、環A' は含窒素複素環式基から窒素原子を除いた基を表し、 X^2 及び X^3 はハロゲン原子を表す。)

で示される化合物とを反応させ、

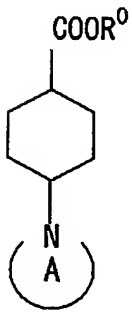
2) 得られる一般式 [V I] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

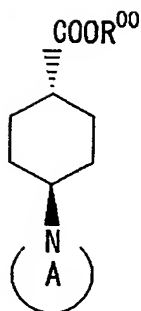
で示される化合物を接触還元し、

3) 得られる一般式 [V I I] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

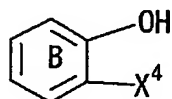
で示される化合物の $COOR^0$ がカルボキシル基である場合は低級アルキルエステル化したのち異性化して一般式 [V I I I] :



(式中、 R^{00} は低級アルキル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)
で示されるトランス型化合物を得、一方、

(B)

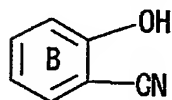
1) 一般式 [IX] :



(式中、環Bは置換されていてもよいベンゼン環もしくはピリジン環、 X^4 は脱離基を表す。)

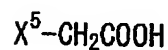
で示される化合物をシアノ化し、

2) 得られる一般式 [X] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

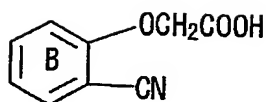
で示される化合物と一般式 [XI] :



(式中、 X^5 はハロゲン原子を表す。)

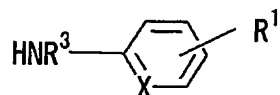
で示される化合物とを反応させ、

3) 得られる一般式 [XII] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

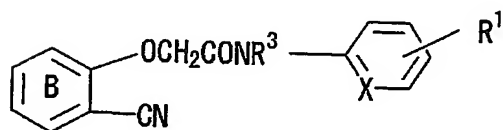
で示される化合物と一般式 [X I I I] :



(式中、 R^3 は水素原子もしくは低級アルキル基、 R^1 は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基もしくは低級アルキルアミノ基、 X は式： $-N=$ もしくは $-CH=$ を表す。)

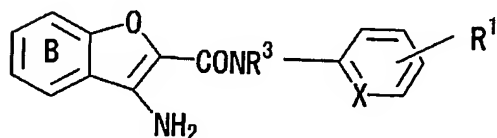
で示される化合物とを反応させ、

4) 得られる一般式 [X I V] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を閉環させて一般式 [X V] :

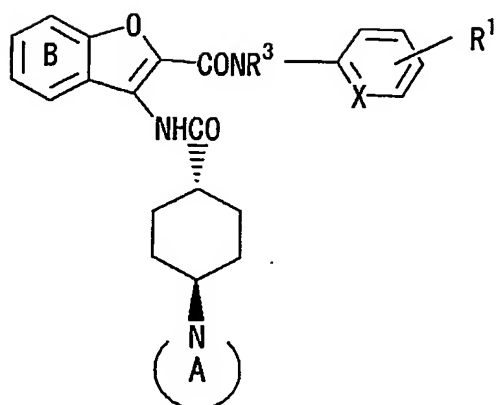


(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を得、

(C)

化合物 [X V] と化合物 [V I I I] もしくはその反応性誘導体とを反応させることを特徴とする一般式 [I] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物またはその塩の製法。

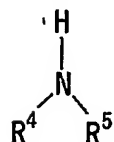
【請求項 2】

一般式 [I I'] :



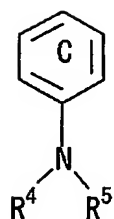
(式中、環 C は置換されていてもよい芳香族環、X¹ は脱離基を表す。)

で示される化合物と一般式 [I I I'] :



(式中、式: NR⁴R⁵ は置換されていてもよいアミノ基もしくは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物とを固相に担持された V I I I 族金属化合物存在下に反応させることを特徴とする一般式 [V I'] :

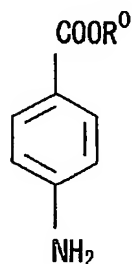


(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

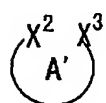
【請求項 3】

一般式 [I V] :



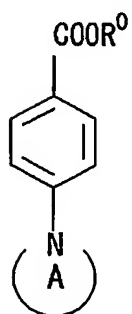
(式中、R⁰は水素原子もしくは低級アルキル基を表す。)

で示される化合物と一般式 [V] :



(式中、環 A' は含窒素複素環式基から窒素原子を除いた基を表し、X²及びX³はハロゲン原子を表す。)

で示される化合物とを反応させることを特徴とする一般式 [V I] :

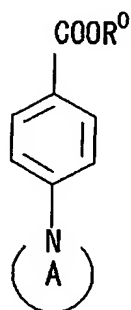


(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、環Aは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物の製法。

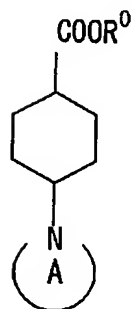
【請求項4】

一般式 [VI] :



(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、環Aは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物を接触還元することを特徴とする一般式 [VII] :

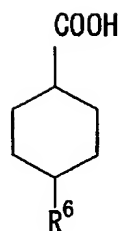


(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

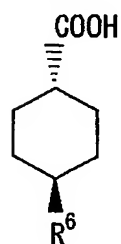
【請求項5】

一般式 [VII'] :



(式中、 R^6 は置換基を表す。)

で示される化合物のカルボン酸誘導体をアルカリ金属アルコキサイド又はアルカリ金属アミドの存在下異性化することを特徴とする一般式 [VII I'] :

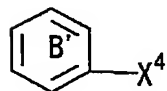


(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるトランス型化合物のカルボン酸誘導体の製法。

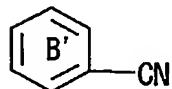
【請求項6】

一般式 [IX'] :



(式中、環 B' は置換されていてもよい芳香族環、 X^4 は脱離基を表す。)

で示される化合物を固相に担持されたVII I族金属化合物存在下シアノ化することを特徴とする一般式 [X'] :

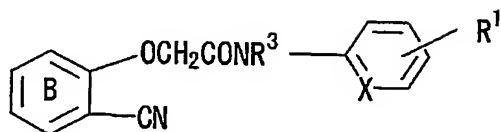


(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

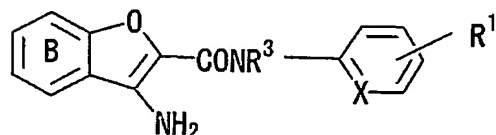
【請求項 7】

一般式 [XIV] :



(式中、環Bは置換されていてもよいベンゼン環もしくはピリジン環、 R^3 は水素原子もしくは低級アルキル基、 R^1 は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基もしくは低級アルキルアミノ基、Xは式： $-N=$ もしくは $-CH=$ を表す。)

で示される化合物を閉環させることを特徴とする一般式 [XV] :



(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

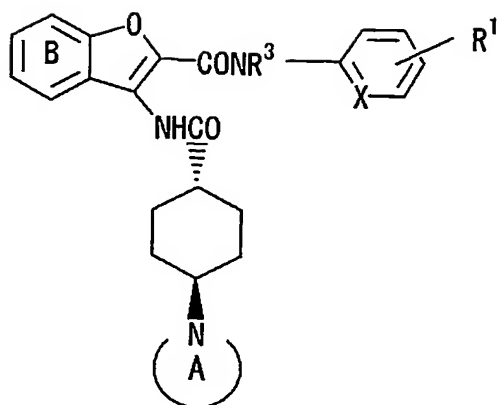
【発明の属する技術分野】

本発明は、医薬、特に活性化血液凝固第X因子阻害剤として有用なベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体又はそれらの薬理的に許容しうる塩の製法に関する。

【0002】

【従来の技術】

特願 2003-3536 及び特願 2003-84865 には、医薬、特に活性化血液凝固第X因子阻害剤として有用な一般式 [I] :



【0003】

(式中、Xは式： $-N=$ または式： $-CH=$ で示される基を示す。R¹は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基、または低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ基を示す。環Aは、含窒素複素環式基を示す。環Bは、置換されていてもよいベンゼン環もしくは置換されていてもよいピリジン環を示す。R³は水素原子または低級アルキル基を示す。)により表されるベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体またはそれらの薬理的に許容しうる塩及びその製法が開示されている。

しかしながら、これら特許出願に開示された製法は工程数が多いため、工程数の少ない工業的に有利な製法の開発が望まれていた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、活性化血液凝固第X因子阻害剤として有用な新規ベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体又はそれらの薬理的に許容しうる塩の効率的で優れた製造方法を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、課題を解決するために鋭意研究した結果、工程数の少ない工業的に優れたベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体又はそれらの薬理的に許容しうる塩の製法を見出し、発明を完成した。

【0006】

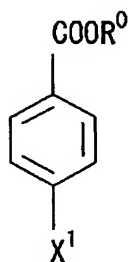
【発明の実施の形態】

本発明は、

1.

(A)

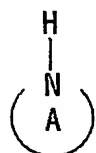
1) - a) 一般式 [I I] :



【0007】

(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、 X^1 は脱離基を表す。)

で示される化合物と一般式 [I I I] :

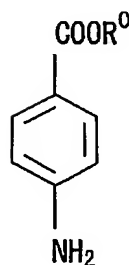


【0008】

(式中、環Aは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物とを反応させるか、

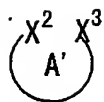
1) - b) 一般式 [I V] :



【0009】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と一般式 [V] :

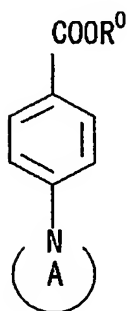


【0010】

(式中、環A' は含窒素複素環式基から窒素原子を除いた基を表し、 X^2 及び X^3 はハロゲン原子を表す。)

で示される化合物とを反応させ、

2) 得られる一般式 [V I] :

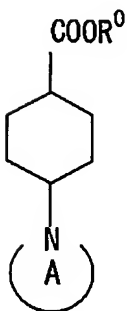


【0011】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を接触還元し、

3) 得られる一般式 [V I I] :

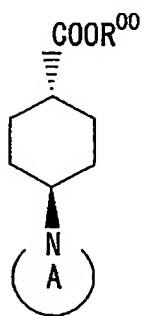


【0012】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の COOR^0 がカルボキシル基である場合は低級アルキルエステル

化したのち異性化して一般式 [VII I] :



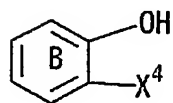
【0013】

(式中、R⁰⁰は低級アルキル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるトランス型化合物を得、一方、

(B)

1) 一般式 [IX] :

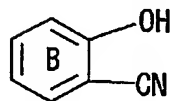


【0014】

(式中、環Bは置換されていてもよいベンゼン環もしくはピリジン環、X⁴は脱離基を表す。)

で示される化合物をシアノ化し、

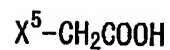
2) 得られる一般式 [X] :



【0015】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と一般式 [XI] :

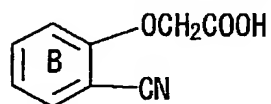


【0016】

(式中、X⁵ はハロゲン原子を表す。)

で示される化合物とを反応させ、

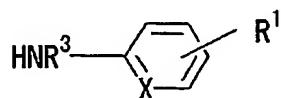
3) 得られる一般式 [X I I] :



【0017】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と一般式 [X I I I] :

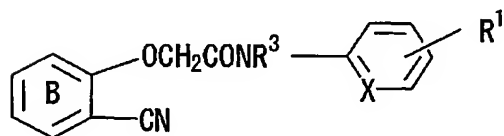


【0018】

(式中、R³は水素原子もしくは低級アルキル基、R¹は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基もしくは低級アルキルアミノ基、Xは式：-N=もしくは-CH=を表す。)

で示される化合物とを反応させ、

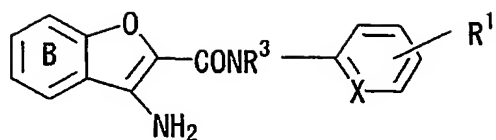
4) 得られる一般式 [X I V] :



【0019】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を閉環させて一般式 [X V] :



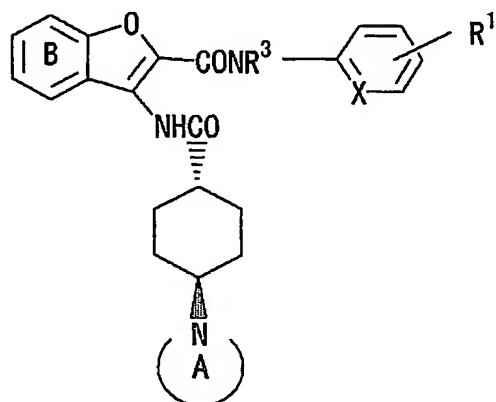
【0020】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を得、

(C)

化合物 [XV] と化合物 [VII] もしくはその反応性誘導体とを反応させることを特徴とする一般式 [I] :



【0021】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物またはその塩の製法。

2.

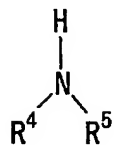
一般式 [II'] :



【0022】

(式中、環Cは置換されていてもよい芳香族環、X¹は脱離基を表す。)

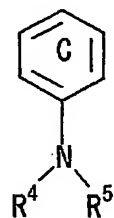
で示される化合物と一般式 [I I I'] :



【 0 0 2 3 】

(式中、式: NR^4R^5 は置換されていてもよいアミノ基もしくは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物とを固相に担持された V I I I 族金属化合物存在下に反応させることを特徴とする一般式 [V I'] :



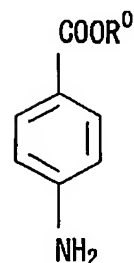
【 0 0 2 4 】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

3.

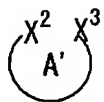
一般式 [I V] :



【 0 0 2 5 】

(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基を表す。)

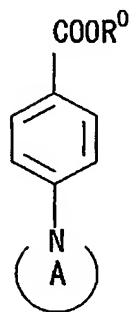
で示される化合物と一般式 [V] :



【0026】

(式中、環A' は含窒素複素環式基から窒素原子を除いた基を表し、 X^2 及び X^3 はハロゲン原子を表す。)

で示される化合物とを反応させることを特徴とする一般式 [V I] :



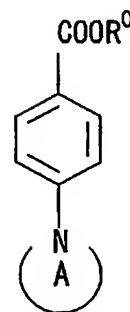
【0027】

(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、環Aは含窒素複素環式基を表す。)

で示される化合物の製法。

4.

一般式 [V I] :

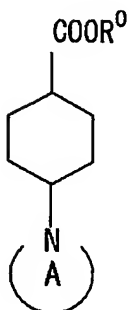


【0028】

(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基、環Aは含窒素複素環式基を表

す。)

で示される化合物を接触還元することを特徴とする一般式 [VII] :



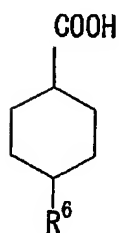
【0029】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

5.

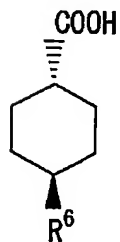
一般式 [VII'] :



【0030】

(式中、R⁶は置換基を表す。)

で示される化合物のカルボン酸誘導体をアルカリ金属アルコキサイド又はアルカリ金属アミドの存在下異性化することを特徴とする一般式 [VII I'] :



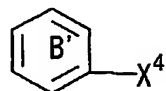
【0031】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるトランス型化合物のカルボン酸誘導体の製法。

6.

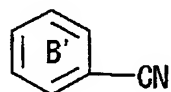
一般式 [I X'] :



【0032】

(式中、環B'は置換されていてもよい芳香族環、X⁴は脱離基を表す。)

で示される化合物を固相に担持されたV I I I族金属化合物存在下シアノ化することを特徴とする一般式 [X'] :



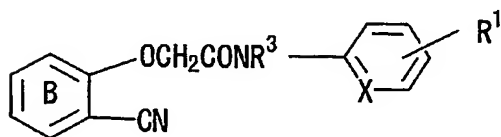
【0033】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

7.

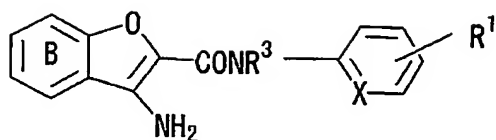
一般式 [XIV] :



【0034】

(式中、環Bは置換されていてもよいベンゼン環もしくはピリジン環、R³は水素原子もしくは低級アルキル基、R¹は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基もしくは低級アルキルアミノ基、Xは式：-N=もしくは-CH=を表す。)

で示される化合物を閉環させることを特徴とする一般式 [XV] :



【0035】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物の製法。

8. パラジウム炭素触媒、配位子及び塩基存在下、窒素雰囲気下を実施することを特徴とする2. 記載の製法。

9. t-ブチルアルコール混合溶媒中で実施することを特徴とする8. 記載の製法。

10. 0～200℃で実施することを特徴とする9. 記載の製法。

11. ロジウム炭素触媒存在下で実施することを特徴とする4. 記載の製法。

12. 0～80℃で実施することを特徴とする5. 記載の製法。

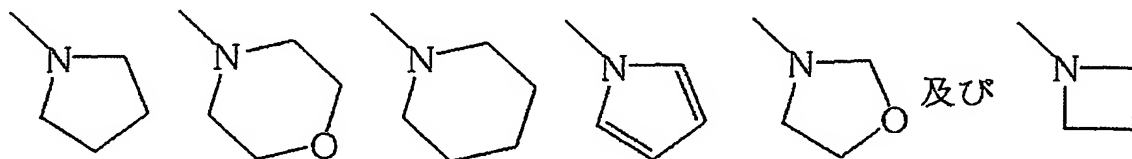
13. パラジウム炭素触媒、亜鉛及び配位子の存在下を実施することを特徴とする6. 記載の製法。

14. 0～200℃で実施することを特徴とする13. 記載の製法。

15. 有機強塩基存在下で実施することを特徴とする7. 記載の製法。

本発明製法の目的物の具体例としては、環Bが、ハロゲン原子、置換されていてもよい低級アルキル基、水酸基、置換されていてもよい低級アルコキシ基、置換されていてもよい飽和異項環基で置換されたオキシ基、置換されたカルボニル基、置換されていてもよいアミノ基、ニトロ基、シアノ基、4, 5-ジヒドロオキサゾリル基及び式： $-C(NH_2)=N-OH$

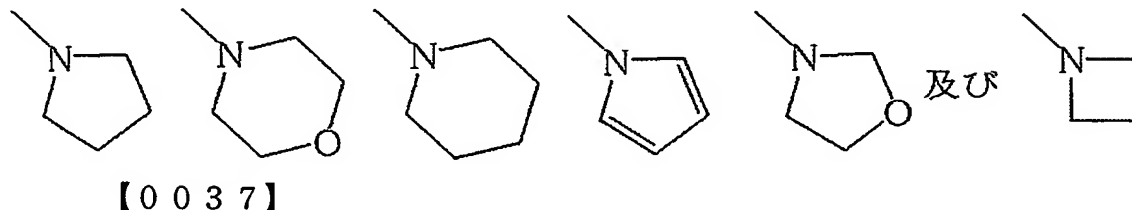
から独立して選ばれる基で置換されていてもよいベンゼン環もしくはピリジン環であり、環Aの含窒素複素環式基が、置換されていてもよい、式：



【0036】

から選ばれる基である化合物があげられる。

このうち、好ましい目的物としては、環Aの含窒素複素環式基が、オキシ基で置換されていてもよい式：



から選ばれる基であり、

環Bの置換基における「置換されていてもよい低級アルキル基」が、

- (1) 低級アルコシカルボニル基、
- (2) カルボキシル基、
- (3) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコシ低級アルキル基、(c) ヒドロキシ低級アルキル基、及び (d) 低級アルコキシ基、から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基、
- (4) モルホリニル基置換カルボニル基、
- (5) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピペリジルカルボニル基、
- (6) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピロリジニルカルボニル基、
- (7) ヒドロキシ基置換ピペリジル基で置換されたカルボニル基、及び
- (8) ヒドロキシル基、

から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキル基であり、

環Bの置換基における「置換されていてもよい低級アルコキシ基」が、

- (1) カルボキシル基、
- (2) 低級アルコシカルボニル基、
- (3) 低級アルコキシ基、
- (4) ヒドロキシル基、
- (5) 低級アルコシカルボニル基で置換されていてもよいアミノオキシ基、
- (6) 低級アルコキシ基で置換された低級アルコキシ基、
- (7) モルホリニル基、ピペリジル基またはピロリジニル基で置換されたカルボニル基、

- (8) ヒドロキシピペリジル基置換カルボニル基、
(9) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピペリジルカルボニル基、
(10) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピロリジニルカルボニル基、
(11) 低級アルキルピペラジニル基置換カルボニル基、
(12) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシカルボニル基、及び (c) 低級アルカノイル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基、
(13) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシ低級アルキル基、(c) ヒドロキシ低級アルキル基、及び (d) ジ低級アルキルアミノ基で置換された低級アルキル基、から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基、及び
(14) 式 —O—NH—C(=NH)NH_2 で示される基、
から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基であり、
環Bの置換基における「置換されていてもよい飽和異項環基で置換されたオキシ基」がアリール基で置換されていてもよい飽和異項環基で置換されたオキシ基であり、
環Bの置換基における「置換されたカルボニル基」が、
(1) 低級アルコキシ基、
(2) ヒドロキシ基、
(3) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシ基、(c) 低級アルコキシ低級アルキル基、(d) ヒドロキシ低級アルキル基、(e) 低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基、(f) アリール基で置換された低級アルキル基、及び (g) ピリジル基置換低級アルキル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基、
(4) モルホリニル基、ピロリジニル基、ピペリジル基またはチオモルホリニル基、
(5) ヒドロキシピペリジル基、
(6) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピペリジル基、
(7) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピロリジニル基、及び
(8) 低級アルキルピペラジニル基、
から選ばれる基で置換されたカルボニル基であり、

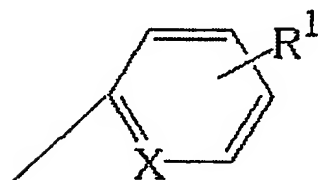
環Bの置換基における「置換されていてもよいアミノ基」が、

- (1) 低級アルキル基、
- (2) 低級アルコキシ低級アルキル基、
- (3) ヒドロキシ低級アルキル基、
- (4) 低級アルカノイル基、
- (5) 低級アルコキシ低級アルカノイル基、
- (6) ヒドロキシ低級アルカノイル基、
- (7) 低級アルカノイルオキシ基置換低級アルカノイル基、
- (8) (a) 低級アルキル基、及び (b) 低級アルカノイル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基で置換された低級アルカノイル基、
- (9) 低級アルコキシカルボニル基、
- (10) アリール基置換低級アルコキシカルボニル基、
- (11) 低級アルキル基で置換されたカルバモイル基、
- (12) 低級アルキルスルホニル基、及び
- (13) モルホリニル基置換低級アルキルスルホニル基、

から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基である化合物があげられる。

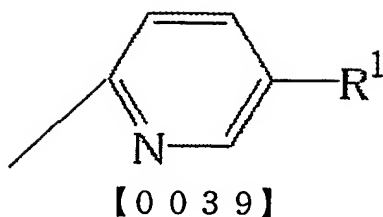
また、飽和異項環基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選択された同一又は異なるヘテロ原子を1～4個有する4～7員の飽和複素環式基があげられるが、具体的には、イミダゾリジニル、ピラゾリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ホモピペラジニル、ホモピペリジニル、ピロリジニル、オキサゾリジニル又は1,3-ジオキサニルがあげられる。

さらに、式：



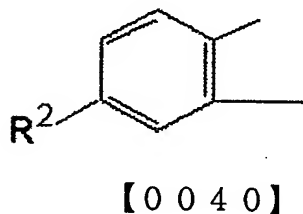
【0038】

が

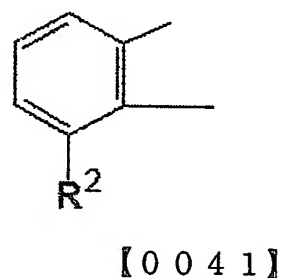


であり、

環Bが



または



であり、

R1がハロゲン原子または低級アルキル基であり、R2が

A) 水素原子、

B) (1) 低級アルコキシカルボニル基、

(2) カルボキシ基、

(3) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシ低級アルキル基、(c) ヒドロキシ低級アルキル基、及び (d) 低級アルコキシ基、から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基、

(4) モルホリニル基置換カルボニル基、

(5) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピペリジルカルボニル基、

(6) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピロリジニルカルボニル基、

(7) ヒドロキシ基置換ピペリジル基で置換されたカルボニル基、及び

(8) ヒドロキシ基、

から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキル基、

- C) (1) カルボキシ基、
(2) 低級アルコキシカルボニル基、
(3) 低級アルコキシ基、
(4) ヒドロキシ基、
(5) 低級アルコキシカルボニル基で置換されていてもよいアミノオキシ基、
(6) 低級アルコキシ基で置換された低級アルコキシ基、
(7) モルホリニル基、ピペリジル基またはピロリジニル基で置換されたカルボニル基、
(8) ヒドロキシピペリジル基置換カルボニル基、
(9) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピペリジルカルボニル基、
(10) ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたピロリジニルカルボニル基、
(11) 低級アルキルピペラジニル基置換カルボニル基、
(12) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシカルボニル基、及び (c) 低級アルカノイル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基、
(13) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシ低級アルキル基、(c) ヒドロキシ低級アルキル基、及び (d) ジ低級アルキルアミノ基で置換された低級アルキル基、から選ばれる基で置換されていてもよいカルバモイル基、及び
(14) 式 —O—NH—C(=NH)NH_2 で示される基、
から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基、または

- D) (1) 低級アルコキシ基、
(2) ヒドロキシ基、
(3) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルコキシ基、(c) 低級アルコキシ低級アルキル基、(d) ヒドロキシ低級アルキル基、(e) 低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基、(f) アリール基で置換された低級アルキル基、及び (g) ピリジル基置換低級アルキル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基、
(4) モルホリニル基、ピロリジニル基、ピペリジル基またはチオモルホリニル基、

- (5) ヒドロキシピペリジル基、
 - (6) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピペリジル基、
 - (7) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピロリジニル基、及び
 - (8) 低級アルキルピペラジニル基、
- から選ばれる基で置換されたカルボニル基、
である化合物があげられる。

本発明製法の目的物としては、具体的には、トランス-5-ジメチルアミノカルボニル-3-[4-(N-ホルミル-N-メチルアミノ)シクロヘキシルカルボニルアミノ]-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミド；

トランス-3-[4-(N-アセチル-N-メチルアミノ)シクロヘキシルカルボニルアミノ]-5-(2-ヒドロキシエチル)-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミド；

トランス-5-(モルホリン-4-イルカルボニル)-3-[4-(2-オキソ-ピロリジン-1-イル)シクロヘキシルカルボニルアミノ]-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミド；

トランス-3-(4-ジメチルアミノシクロヘキシルカルボニルアミノ)-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミド
があげられる。

【0042】

本発明の目的物の薬理学的に許容しうる塩としては、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などの無機酸との塩、あるいはギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マイレン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸などの有機酸との塩、またはアスパラギン酸、グルタミン酸などの酸性アミノ酸との塩、ナトリウム、カリウム、リチウム、マグネシウム、カルシウム、アルミニウムなどの金属との塩、メチルアミン、エチルアミン、エタノールアミンなどの有機塩基との塩、あるいはリジン、オルニチンなどの塩基性アミノ酸との塩などがあげられる。

【0043】

本発明の目的物は4級アンモニウム塩とすることもでき、4級アンモニウム塩も包含される。

【0044】

また、本発明の目的物は、分子内塩、水和物、溶媒和物や結晶多形のものなども包含される。

【0045】

また、本発明の目的物に二重結合を有する場合は幾何異性体（シス体、トランス体）として存在し、本発明の目的物にカルボニルなどの不飽和結合を有する場合は互変異性体として存在し、さらに、本発明目的物に不斉炭素を有する場合は光学異性体として存在するが、本発明の目的物は、それら異性体あるいはそれらの混合物を包含する。

【0046】

また、本発明の目的物には、前記の化合物のプロドラッグも含まれる。プロドラッグとしては、例えば、アミノ、カルボキシなどの官能基を、通常用いられる保護基を用いて保護したものなどがあげられる。

化合物 [I I] と化合物 [I I I] との反応及び化合物 [I I'] と化合物 [I I I'] との反応は、触媒、配位子及び塩基の存在下、窒素雰囲気下、適当な溶媒中で実施することができる。脱離基としては、ハロゲン原子、アリールスルホニルオキシ基、低級アルキルスルホニルオキシ基、パーハロゲノ低級アルキルスルホニルオキシ基等のスルホン酸エステル残基等を好適に用いることができる。触媒としては、均一系の触媒でも、不均一系の触媒でも用いることができるが、コスト面からは回収が可能な不均一系の触媒が好ましい。均一系の触媒としては、酢酸パラジウム等が、不均一系の触媒としては、固相に担持されたV I I I族金属化合物があげられるが、とりわけ不均一系の触媒である固相に担持されたV I I I族金属化合物を用いるのが好ましい。固相に担持されたV I I I族金属化合物の固相としては、炭素や粘土鉱物があげられ、V I I I族金属としては、パラジウム、ニッケルがあげられるが、とりわけ、パラジウム炭素が好ましい。配位子としては、2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチ

ル、1, 1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン等のジフェニルホスフィノ化合物、トリフェニルホスフィン等を好適に用いることができる。塩基としては、炭酸セシウム、炭酸カリウムの如き炭酸金属塩、水酸化カリウムの如き水酸化アルカリ金属、ナトリウム *t*-ブトキサイドの如きアルカリ金属アルコキサイド、酢酸ナトリウムの如き酢酸アルカリ金属を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、トルエン、キシレン、メシチレンを好適に用いることができる。また溶媒として、*t*-ブチルアルコールを混合することにより反応はより進行し、その混合割合としては、他の溶媒 4 に対して *t*-ブチルアルコール 1 程度が好ましい。本反応において、使用するパラジウム触媒の量は、化合物 [II] 及び化合物 [II'] に対して 0.001~0.1 当量、より好ましくは 0.04~0.06 当量であり、最も好ましくは 0.04 当量であり、使用する配位子の量は、化合物 [II] 及び化合物 [II'] に対して 0.002~0.2 当量、より好ましくは 0.08~0.16 当量であり、最も好ましくは 0.08 当量であり、使用する塩基の量は、化合物 [II] 及び化合物 [II'] に対して 1~2 当量、より好ましくは 1.4~2 当量であり、最も好ましくは 2 当量である。本反応は、冷却下~加熱下、具体的には 0~200℃、とりわけ 100~140℃で好適に進行する。

【0047】

なお、化合物 [II'] の芳香族環としては、6~24 個の環炭素原子を有する炭素環式芳香族環または 5~24 個の環炭素原子を有するヘテロ芳香族環があげられるが、具体的には、ベンゼン環、ナフタレン環、インドール環などがあげられる。またその置換基としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコシキカルボニル基、ホルミル基、カルボキシ基置換アリール基などがあげられる。

【0048】

化合物 [III'] における式: NR^4R^5 の置換されていてもよいアミノ基の例としては、

(1) 低級アルキル基、

- (2) シクロアルキル基、
- (3) ヒドロキシ低級アルキル基、
- (4) 低級アルキル基で置換された 1, 3-ジオキサニル基、
- (5) (a) 低級アルキル基、(b) 低級アルカノイル基、(c) 低級アルキル基置換アミノ基で置換された低級アルカノイル基及び (d) 低級アルコキシカルボニル基、から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基、
- (6) シアノ基置換低級アルキル基、
- (7) 低級アルコキシカルボニル基置換低級アルキル基、
- (8) カルボキシル基置換低級アルキル基、
- (9) 低級アルキル基で置換されていてもよいカルバモイル基置換低級アルキル基、
- (10) アリール基で置換された低級アルキル基、
- (11) ピリジル基置換低級アルキル基、
- (12) 低級アルコキシカルボニル基、
- (13) ジ低級アルキルアミノ基置換低級アルカノイル基、
- (14) 低級アルカノイル基、
- (15) ピリミジニル基、
- (16) モルホリニル基置換低級アルカノイル基、
- (17) 低級アルキルスルホニル基、
- (18) 低級アルキル基置換カルバモイル基、
- (19) アリール基置換カルボニル基、
- (20) 低級アルコキシ基置換低級アルカノイル基、
- (21) 低級アルカノイルオキシ基置換低級アルカノイル基、
- (22) ヒドロキシ基置換アリール基、及び
- (23) ヒドロキシ低級アルカノイル基、

から選ばれる基で置換されていてもよいアミノ基があげられ、含窒素複素環式基としては、窒素原子を 1 つ以上含有する 4 ~ 7 員の飽和又は不飽和複素環式基があげられ、具体的には、イミダゾリジニル、ピラゾリジニル、ピペリジル、ピペ

ラジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ホモピペラジニル、ホモピペリジニル、ピロリジニル、オキサゾリジニル又は1, 3-ジオキサニル等があげられる。

化合物 [I V] と化合物 [V] との反応は、塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。塩基としては、水酸化ナトリウムの如き水酸化アルカリ金属、炭酸ナトリウムの如き炭酸アルカリ金属、N, N-ジイソプロピルエチルアミンの如き有機アミンを好適に用いることができるが、特に塩基性の強い塩基、具体的には水酸化ナトリウムの如き水酸化アルカリ金属が好ましい。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、トルエンと水の混合溶媒、酢酸エチルと水との混合溶媒を好適に用いることができるが、水との混合溶媒を用いることが好ましい。その混合割合としては、有機溶媒 1 に対して水 3 ~ 4、とりわけ、水 4 程度が好ましい。本反応において、使用する塩基の量は、化合物 [I V] に対して 2 ~ 10 当量、より好ましくは 3 ~ 5 当量であり、最も好ましくは 4 当量である。本反応は、低温下、例えば、0 ~ 30 °C で好適に進行する。

化合物 [V I] の接触還元は、触媒の存在下、水素加圧 (9 a t m) 下、適当な溶媒中で実施することができる。触媒としては、ロジウム炭素触媒を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、メタノール、水を好適に用いることができる。本反応において、使用する触媒の量は、化合物 [V I] に対して 0.01 ~ 0.1 当量、より好ましくは 0.015 ~ 0.03 当量であり、最も好ましくは 0.015 当量である。本反応は、-20 °C ~ 加温下、例えば、室温 ~ 100 °C で好適に進行する。

化合物 [V I I] の COOR^0 がカルボキシ基である場合の低級アルキルエステル化は常法により実施することができる。例えば、適当な溶媒中、硫酸などの酸性条件下低級アルカノールで処理することにより実施することができる。

化合物 [V I I] 及び化合物 [V I I'] の異性化反応は、塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。塩基としては、ナトリウムメトキシイドの如きアルカリ金属アルコキシイド、ヘキサメチルジシラザンナトリウム、ヘキサメ

チルジシラザンカリウム、ヘキサメチルジシラザンリチウム、リチウムジイソプロピルアミドの如きアルカリ金属アミド等を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、メタノールを好適に用いることができる。本反応において、使用する塩基の量は、化合物 [VII] 及び化合物 [VII'] に対して 1~2 当量、より好ましくは 1.4~2 当量であり、最も好ましくは 2 当量である。本反応は、冷却下~加熱下、例えば、-20~150℃で進行するが、好ましくは、0~80℃、より好ましくは室温 (0~25℃) で好適に進行する。

【0049】

なお、化合物 [VII'] における置換基としては、いかなる基であっても好適に反応は進行する。また、化合物 [VII'] のカルボン酸誘導体としては、エステル、活性化エステル、酸ハライド、ニトリル、アミド、チオールエステル等を用いることができる。

化合物 [IX] 及び化合物 [IX'] のシアノ化反応は、触媒、亜鉛及び配位子の存在下、シアノ化剤で処理することにより実施することができる。脱離基としては、ハロゲン原子、アリアルスルホニルオキシ基、低級アルキルスルホニルオキシ基、パーハロゲノ低級アルキルスルホニルオキシ基等のスルホン酸エステル残基等を好適に用いることができる。触媒としては、均一系の触媒でも、不均一系の触媒でも用いることができるが、コスト面からは回収が可能な不均一系の触媒が好ましい。均一系の触媒としては、酢酸パラジウム等が、不均一系の触媒としては、固相に担持された VII 族金属化合物があげられるが、とりわけ不均一系の触媒である固相に担持された VII 族金属化合物を用いるのが好ましい。固相に担持された VII 族金属化合物の固相としては、炭素や粘土鉱物があげられ、VII 族金属としては、パラジウム、ニッケルがあげられるが、とりわけ、パラジウム炭素が好ましい。配位子としては、トリフェニルホスフィン、1, 1'-ビス (ジフェニルホスフィノ) フェロセンを好適に用いることができる。シアノ化剤としては、シアン化亜鉛、シアン化銅、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、アセトンシアノヒドリル等を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、ジ

メチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドンを好適に用いることができる。本反応において、使用するパラジウム触媒の量は、化合物 [IX] 及び化合物 [IX'] に対して 0.001~0.1 当量、より好ましくは 0.01~0.05 当量であり、最も好ましくは 0.05 当量であり、使用する配位子の量は、化合物 [IX] 及び化合物 [IX'] に対して 0.004~0.4 当量、より好ましくは 0.04~0.2 当量であり、最も好ましくは 0.2 当量であり、使用する亜鉛の量は、化合物 [IX] 及び化合物 [IX'] に対して 0.1~1 当量、より好ましくは 0.2~0.6 当量であり、最も好ましくは 0.4 当量である。本反応は、冷却下~加熱下、具体的には 0~200℃、とりわけ、80~150℃で好適に進行する。

【0050】

なお、化合物 [IX'] の芳香族環としては、6~24 個の環炭素原子を有する炭素環式芳香族環または 5~24 個の環炭素原子を有するヘテロ芳香族環があげられるが、具体的には、ベンゼン環、ピリジン環、ナフタレン環、インドール環などがあげられる。またその置換基としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコシキカルボニル基、ホルミル基、カルボキシ基置換アリール基などがあげられる。

化合物 [X] と化合物 [XI] との反応は、ハロゲン化剤及び塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。ハロゲン化剤としては、ヨウ化ナトリウム、臭化ナトリウムの如きハロゲン化アルカリ金属を好適に用いることができる。塩基としては、炭酸カリウムの如き炭酸アルカリ金属を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、アセトンを好適に用いることができる。本反応は、室温~加温下、例えば、20~60℃で好適に進行する。

化合物 [XII] と化合物 [XIII] との反応は、ハロゲン化剤及び塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。ハロゲン化剤としては、塩化チオニル、塩化オキサリル等を好適に用いることができる。塩基としては、トリエチルアミンの如き有機アミンを好適に用いることができる。溶媒としては、反応に

支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、塩化メチレンを好適に用いることができる。本反応は、室温～加温下、例えば、20～70℃で好適に進行する。

化合物 [XIV] の閉環反応は、塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。塩基としては、有機強塩基であることが望ましく、例えば、1, 8-ジアザビシクロ [5. 4. 0] ウンデカー 7-エンの如き有機アミン、ビス (トリメチルシリル) ソジウムアミド等を好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、テトラヒドロフランを好適に用いることができる。本反応において、使用する塩基の量は、化合物 [XIV] に対して 0.05～2.2 当量、より好ましくは 1.2～2.2 当量であり、最も好ましくは 1.2 当量である。本反応は、室温～加温下、例えば、20～100℃で好適に進行するが、40～70℃がより好ましい。

化合物 [XV] と化合物 [VII] もしくはその反応性誘導体との反応は、塩基の存在下、適当な溶媒中で実施することができる。塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1, 8-ジアザビシクロ [5. 4. 0] ウンデカー 7-エン、1, 4-ジアザビシクロ [2. 2. 0] オクタン等の如き有機塩基を好適に用いることができる。化合物 [VII] の反応性誘導体としては、対応する酸ハライドを好適に用いることができる。溶媒としては、反応に支障をきたさない不活性溶媒であれば制限がなく、例えば、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭素やテトラヒドロフランを好適に用いることができる。本反応は、氷冷下～加温下、例えば、15～25℃で好適に進行する。

本発明の化合物 [II'] と化合物 [III'] との反応によれば、芳香族環上に、置換されていてもよいアミノ基もしくは含窒素複素環式基を、1段階で安価に導入することができる。

本発明の化合物 [IV] と化合物 [V] との反応によれば、カルボキシル基を有するベンゼン環上に、含窒素複素環式基を、実質的に1段階で安価に導入することができる。

本発明の化合物 [VI] の接触還元によれば、シクロヘキシル基の1位及び4位

にカルボキシル基と含窒素複素環式基を有する化合物を安価に製造することができる。

本発明の化合物 [V I I'] の異性化反応によれば、シクロヘキシル基の 1 位及び 4 位にカルボキシル基と置換基を有する化合物のトランス体を、比較的低温で安価に製造することができる。

本発明の化合物 [I X'] のシアノ化反応によれば、芳香族環上にシアノ基を 1 段階で安価に導入することができる。

本発明の化合物 [X I V] の閉環反応によれば、化合物 [X I V] を比較的低温で製造することができる。

本明細書中の一般式の定義において「低級」なる用語は、特に断らない限り、炭素数が 1 乃至 6 の直鎖又は分枝状の炭素鎖を意味する。

【0051】

従って、「低級アルキル基」としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert-ペンチル、1-メチルブチル、2-メチルブチル、1, 2-ジメチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、1-メチルペンチル、2-メチルペンチル、3-メチルペンチル、1, 1-ジメチルブチル、1, 2-ジメチルブチル、2, 2-ジメチルブチル、1, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、3, 3-ジメチルブチル、1-エチルブチル、2-エチルブチル、1, 1, 2-トリメチルプロピル、1, 2, 2-トリメチルプロピル、1-エチル-1-メチルプロピル、1-エチル-2-メチルプロピル等が挙げられる。これらの中では炭素数 1 乃至 4 のものが好ましく、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチルが特に好ましい。

【0052】

また、「低級アルコキシ基」としては、上記低級アルキル基に酸素原子が結合した置換基を意味する。これらの中では炭素数 1 乃至 4 のものが好ましく、メトキシ、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基が特に好ましい。

【0053】

「低級アルカノイル」としては、低級カルボン酸のカルボキシル基からOH基を除いてできる基が挙げられる。具体的には、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリルなどがあげられる。

【0054】

「ハロゲン原子」としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を意味する。好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子が挙げられる。

【0055】

「アリール基」としては、フェニル基又はナフチル基を意味する。好ましくはフェニル基が挙げられる。

【0056】

【実施例】

以下、実施例をもって本発明をさらに詳しく説明するが、これらの実施例は本発明を制限するものではない。

【0057】

実施例 1

Pd/C (125 mg, 0.12 mmol) および 2, 2'-ビス (ジフェニルホスフィノ) 1, 1'-ビナフチル (146 mg, 0.23 mmol) を窒素気流下、キシレン (4 mL) および t-ブチルアルコール (1 mL) 混液に懸濁した。懸濁液に対し、4-クロロ安息香酸メチル (0.5 g, 2.93 mmol)、2-ピロリドン (330 mL, 4.34 mmol) および炭酸カリウム (0.8 g, 5.79 mmol) を添加し、130 °C にて加熱還流した。還流開始より 18 時間後、反応液を冷却し、不溶物をろ過した。ろ液に濃塩酸 (1.4 g) を添加して中和し、得られた溶液を用いて HPLC 分析より生成物の定量を行ったところ、4-(2-ピロリドン-1-イル) 安息香酸メチル (0.62 g, 96.7%) の生成を確認した。

mp 120-121°C.

実施例 2

4-アミノ安息香酸 (100 g, 0.73 mol) を水 (400 mL) およびトルエン (200 mL)

に懸濁後、氷冷下30% 水酸化ナトリウム水溶液 (97 g, 0.73 mol)を滴下した。pHが十分に塩基性となったことを確認し、4-クロロ酪酸クロリド* (103 g, 0.73 mol)および30%水酸化ナトリウム水溶液 (290 g, 2.2 mol)を、pHを9-12、温度を15-20℃の範囲に保ちつつ1時間かけて同時に滴下した。1時間室温にて攪拌後、氷冷下水酸化ナトリウム (88 g, 2.2 mol)を添加した。反応液に濃塩酸 (370 g)を30℃以下にて添加し、析出晶をろ取した。得られた結晶を水洗した後、40℃にて送風乾燥した結果、4-(2-ピロリドン-1-イル)安息香酸を144 g (96.0%yd, 98.3%purity)得た。ただし、純度はHPLC分析により求めた。
mp 246-247℃.

実施例 3

300mLオートクレープに4-(2-ピロリドン-1-イル)安息香酸 (4.0g, 0.0195mol)、5%ロジウム炭素触媒(6.89 g, 1.5%mol)、メタノール(200mL)を仕込み、水素圧9 atmで室温下24時間攪拌した。(変換率 >99%, cis:trans=75:25)。反応液を100mlまで濃縮し、濃塩酸(11g)でpH2としたのち、クロロホルム(100mL)で3回抽出した。有機層を集めて飽和食塩水(100mL)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、結晶をトルエンで集めて、50℃で終夜送風乾燥し、4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸を得た(19.3 g, 93.7%, cis:trans=65:35)。

【0058】

実施例 4

4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸にエタノール30mL (10V/W)と濃硫酸0.4g (0.2W/W)を加え、3.5時間加熱還流する。反応液を10℃に冷却し、重曹(粉末)を加え、発泡が停止した後、エタノールを減圧留去した。残渣に酢酸エチルと飽和食塩を加えて抽出後硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧濃縮により4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸エチル (oil, 2.3g, 102%)を得た。

【0059】

実施例 5

4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸エチル (5.0g, シスとトランスの異性体混合物、cis:trans=61:39) にエタノール (25.0mL, 5V/W) とナトリウムエトキシド (2.0equiv. 0.0132mol) を加え、室温で20時間攪拌した。反応液に水 (5.0mL, 1V/W) をくわえ、2時間室温で攪拌後エタノールを減圧留去した。残渣に2規定の塩酸を加え酸性とし、過剰量の結晶の食塩を加えた後 (飽和させて塩析)、塩化メチレンで抽出した。抽出液を乾燥し、溶媒留去後得られた結晶をトルエンで集め、2.9 g (トランス:シス=88:12、収率 58%) の4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸エチルを得た。

【0060】

実施例 6

3-ブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸 (50 g, 0.23 mmol) を塩化メチレンに懸濁し、塩化チオニル (54.8 g, 0.46 mol)、ジメチルホルムアミド (0.92 mL, 0.0115 mol) を順次室温下加えた。反応液を一時間還流させた後、溶媒を減圧下留去した。塩化メチレン (150 mL) で一回置換濃縮し、対応する酸クロリドを得た。調製した酸クロリドを塩化メチレン (250 mL) に溶解し、氷冷下、モルホリン (100.4 g, 1.15 mol) を15℃を越えないように滴下した。2時間半攪拌した後、溶媒を減圧濃縮した。濃縮残渣に水 (500 mL) と塩化メチレン (10 mL) を加えて懸濁し、濃塩酸 (96 mL) で pH = 1~2 にした。氷冷下、一時間攪拌した後、濾取して3-ブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミドの粗結晶を 65.74 g (99.9%) 得た。粗結晶をメタノール (329 mL) で還流下30分温浸した後に徐冷し、氷冷下1時間攪拌した後、析出晶を濾取し、3-ブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミド (58.14 g, 88.4%) を得た。
mp 216-218℃.

実施例 7

3-ブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミド (286 mg,

1 mmol)、シアン化亜鉛 (70 mg, 0.6 mmol), 10% Pd/C (53 mg, 0.05 mmol), 亜鉛 (36 mg, 0.56 mmol), 1,1'-ビス(シフェニルホスフィノ)フェロセン (28 mg, 0.05 mmol) をジメチルacetアミド (2.9 mL) に懸濁後、減圧下脱気し、窒素置換した (x 3 回)。反応混合物を 150~155℃ に加熱し、1 時間攪拌した。冷却後、不溶物をろ過し、反応液を HPLC にて定量した結果、3-シアノー-4-ヒドロキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミドを 203 mg (87.4%) 得た。

mp 238-240℃.

実施例 8

3-シアノー-4-ヒドロキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミド (232 mg, 1.0 mmol)、ヨウ化ナトリウム (150 mg, 1.0 mmol), 炭酸カリウム (415 mg, 3.0 mmol), クロロ酢酸 (189 mg, 2.0 mmol) をアセトン (12 mL) に懸濁し、5 時間還流させた。減圧下、溶媒を留去して、水、酢酸エチルに分配し、塩酸で pH=2~3 に調整した。分液後、水層を酢酸エチルで二回再抽出し、合わせて飽和食塩水洗浄を行った。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させた後、溶媒を減圧下濃縮し、析出した粗結晶をメタノール-ジエチルエーテルで懸濁して濾取し、3-シアノー-4-カルボキシメトキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミドを 241 mg (83%) 得た。

mp 205-206℃.

実施例 9

3-シアノー-4-カルボキシメトキシ安息香酸 (4-モルホリニル) アミド (150 mg, 0.517 mmol) をトルエン (3 mL) とクロロホルム/アミレン (3 mL) に懸濁し、塩化チオニル (615 mg, 5.17 mmol)、ジメチルホルムアミド (2 drops) を順次室温下加えた。反応液を 70℃ で一時間攪拌した後、溶媒を減圧下留去し、対応する酸クロリドを得た。調製した酸クロリドを塩化メチレン (3 mL) に溶解し、氷冷下、5-アミノ-3-クロロピリジン (66 mg, 0.517 mmol) およびトリエチルアミン (0.15 ml, 1.03 mmol) の塩化メチレン (1 mL) 懸濁液を滴下した。1 時間半攪拌した後、溶媒を減圧濃縮した。濃縮残渣に水とアセトンを加えて懸濁し

、析出晶を濾取して 3-シアノ-4-(5-クロロピリジン-2-イルアミノカルボニルメトキシ)安息香酸(4-モルホリニル)アミド(141 mg, 68%)を得た。

mp 165-167°C.

実施例 10

3-シアノ-4-(5-クロロピリジン-2-イルアミノカルボニルメトキシ)安息香酸(4-モルホリニル)アミド(10g)を室温下テトラヒドロフラン(50ml)に懸濁し、1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカー-7-エン(4.56g)を滴下後、70°Cに加温し2時間攪拌した。反応終了確認後、室温まで冷却し、30°C以下で水(150ml)を滴下し、30分間室温で攪拌した。析出晶をろ別し、結晶を水で洗浄後、50°Cにて乾燥させることにより、3-アミノ-5-(モルホリニル-4-イルカルボニル)-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミドを得た(収量:7.87g(78.7%))。

mp 244-245°C.

実施例 11

Trans-4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸(2.37g)を氷冷下クロロホルム(9ml)に懸濁し、SOCl₂(2.00g)を滴下後、10°Cで15分間攪拌した。原料の消失を確認後、反応液を減圧下留去し、trans-4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸の酸クロリド体を得た。一方、3-アミノ-5-(モルホリニル-4-イルカルボニル)-N-(5-クロロピリジン-2-イル)ベンゾフラン-2-カルボキサミド(3.00g)を氷冷下ピリジン(21ml)に懸濁し、先に得られたtrans-4-(2-ピロリドン-1-イル)シクロヘキシルカルボン酸の酸クロリド体をクロロホルム(10ml)に懸濁し滴下した。室温で20時間攪拌し、反応終了を確認後、反応液を水にあげ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を留去し、メタノールで結晶化させ、50°Cで送風乾燥させることによりトランス-5-(モルホリニル-4-イルカルボニル)-3-[4-(2-オキソ-ピロリジン-1-イル)シクロヘキシルカルボニルアミノ]-N-(5-クロロ

ピリジン-2-イル) ベンゾフラン-2-カルボキサミドを得た (収量: 2.74g (61.6%))。

【0061】

mp 253-255°C.

【0062】

【発明の効果】

本発明によれば、活性化血液凝固第X因子阻害剤として有用なベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体又はそれらの薬理的に許容しうる塩を効率的に製造することができる。

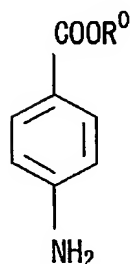
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 活性化血液凝固第X因子阻害剤として有用なベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体又はそれらの薬理的に許容しうる塩の効率的で優れた製造方法を提供する。

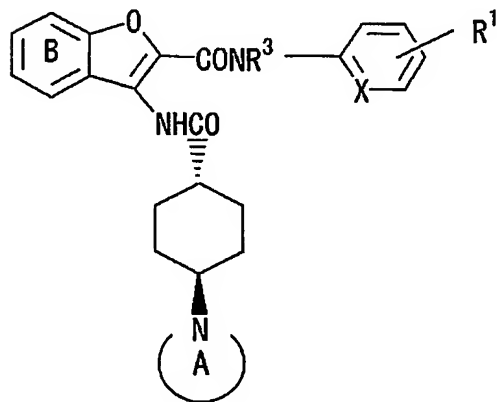
【解決手段】

一般式 [I V] :



(式中、 R^0 は水素原子もしくは低級アルキル基を表す。)

で示される化合物等を出発物質とする一般式 [I] :



(式中、Xは式： $-N=$ または式： $-CH=$ で示される基を示す。 R^1 は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、シアノ基、または低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ基を示す。環Aは、含窒素複素環式基を示す。環Bは、置換されていてもよいベンゼン環もしくは置換されていてもよいピリジン環を示す。 R^3 は水素原子または低級アルキル基を示す。)により表されるベンゾフラン誘導体もしくはピリドフラン誘導体またはそれらの薬理的に



許容しうる塩の製法。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-186370
受付番号	50301083809
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年 7月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 6月30日

特願 2003-186370

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000002956]

1. 変更年月日
[変更理由]
住所
氏名

1990年 9月20日
新規登録
大阪府大阪市中央区道修町3丁目2番10号
田辺製薬株式会社